# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-213484

(43)Date of publication of application: 30.07.2003

(51)Int.CI.

3/66 C25D

C25D 5/26

(21)Application number: 2002-007030

(71)Applicant:

NIPPON STEEL CORP

(22)Date of filing:

16.01.2002

(72)Inventor:

KAYAMA KOICHIRO

NISHIMURA KAZUMI

HAYASHI KIMITAKA

# (54) Mg-ADDED ELECTROGALVANIZING BATH, AND PLATING METHOD USING THE BATH

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a low-temperature Mg-added electrogalvanizing bath for solving the problem of material degradation in a material to be plated at plating caused by the conventionally used high-temperature plating bath and also to provide a plating method for securing excellent plating appearance and plating adhesion by using the bath.

SOLUTION: In the Mg-added electrogalvanizing bath, Zn halide and Mg metal or Mg metallic salt are added to a solution consisting of ethyl-methyl- imidazolium halide and either or both of polyhydric alcohol and an organic compound having carbonyl group. In the Mgadded electrogalvanizing method, plating is carried out using the above plating bath at 50 to 250° C bath temperature and (0.1 to 300) A/dm2 current density.

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-213484

(P2003-213484A)

(43) 公開日 平成15年7月30日(2003.7.30)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード (参考)

C25D 3/66

5/26

C25D 3/66

5/26

4K024

F

審査請求 未請求 請求項の数2

OL (全4頁)

(21)出願番号

特願2002-7030(P2002-7030)

(22)出願日

平成14年1月16日(2002.1.16)

(71)出願人 000006655

新日本製鐵株式会社

利日本毁毁休氏云社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

(72) 発明者 香山 滉一郎

兵庫県飾磨郡夢前町新庄1194番地

(72)発明者 西村 一実

姫路市広畑区富士町1番地 新日本製鐵株

式会社広畑製鐵所内

(74)代理人 100062421

弁理士 田村 弘明 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】Mg添加電気Znめっき浴およびその浴によるめっき方法

## (57)【要約】

【課題】 従来のめっき浴が高温浴のため、被めっき材がめっき時にその材質が劣化するという課題を解決するために、低温のMg添加電気Znめっき浴、及びその浴を用いて良好なめっき外観、めっき密着性を確保するめっき方法を提供する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 エチルメチルイミダゾリウムハロゲン化 物と2価以上のアルコールもしくはカルボニール基をも つ有機化合物の一方又は両方よりなる溶液に、Znハロ ゲン化物とMg金属もしくは金属塩を添加してなること を特徴とするMg添加電気Znめっき浴。

1

【請求項2】 請求項1に記載のめっき浴を用いて、浴 温50~250℃、電流密度0. 1~300A/d m² でめっきすることを特徴とするMg添加電気Znめっき 方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、低温でめっきでき るMg添加電気Znめっき浴、及びその浴によるめっき 方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、自動車、家電、建材用途の高耐食 性を目的とした電気Zn系合金めっきの製造法として は、めっき浴として水溶液を用いた乙n-Ni、乙n-Ni-Co、Zn-Feなどのめっきが一般的に実用化 20 されている。一方、実用化には至っていないものの、さ らなる高耐食性を有することが期待されるMgを含有す るZnめっきは、通常の水溶液からの電気めっきが不可 能であるため、高温のハロゲン化物浴を用いた溶融塩電 解を中心として若干検討されているにすぎない。

【0003】例えば特開平4-180592号におい て、Zn塩化物およびMg塩化物ならびにNa、K, L iの塩化物の1種又は2種以上からなるめっき浴を用い て温度350~500℃、電流密度20~350A/d m<sup>2</sup> で電気めっきすることが開示されている。この方法 30 は、浴成分の融点が高いため350℃以上の高温浴を用 いるため、被めっき材がめっき時高温にさらされるため にその材質が劣化するという課題を有しており、低温の めっき浴の開発が望まれていた。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 従来技術の問題点である、高温浴のため被めっき材がめ っき時にその材質が劣化するという課題を解決するため に、低温のMg添加電気Znめっき浴、及びその浴を用 いて良好なめっき外観、めっき密着性を確保するめっき 40 方法を提供することである。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記の課 題を解決するために各種のめっき浴の検討を行ったとこ ろ、新たな知見として、特定の有機系の溶液に Z n ハロ ゲン化物、Mg金属あるいは金属塩を添加した場合に、 低温でこれらのZnハロゲン化物とMg金属あるいは金 属塩を溶解できるMg 添加電気 Zn めっき浴、およびそ の浴を用いて特定の電解条件(浴温、電流密度)でめっ きした場合に、良好なめっき外観、めっき密着性を付与 50 は、溶液の蒸発が激しく使用し難いためである。

できるめっき方法を見いだした。

【0006】本発明は、上記知見を基に完成したもの で、その要旨とするところは下記の通りである。

(1) エチルメチルイミダゾリウムハロゲン化物と2 価以上のアルコールもしくはカルボニール基をもつ有機 化合物の一方又は両方よりなる溶液に、乙nハロゲン化 物とMg金属もしくは金属塩を添加してなることを特徴 とするMg添加電気Znめっき浴。

(2) 上記(1)に記載のめっき浴を用いて、浴温5 10 0~250℃、電流密度0.1~300A/dm<sup>2</sup>でめ っきすることを特徴とするMg添加電気Znめっき方

【0007】上記エチルメチルイミダゾリウムハロゲン 化物としては、エチレンイミダゾールブロマイド、エチ レンイミダゾールクロライド等が使用できる。 2 価以上 のアルコールとしては、エチレングリコール、プロピレ ングリコール等が使用できる。さらに、Znハロゲン化 物としては、臭化亜鉛あるいは塩化亜鉛、Mg金属塩と しては臭化Mgが使用できる。なお上記(1)のめっき 浴にポリエチレングリコールを添加するのが、Mgの電 析を促進させる上で好ましい。

#### [0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 (Mg添加電気Znめっき浴の調製) 本発明のMg添加 電気乙nめっき浴は、エチルメチルイミダゾリウムハロ ゲン化物と2価以上のアルコールおよび/もしくはカル ボニール基をもつ有機化合物よりなる溶液に、Znハロ ゲン化物とMg金属もしくは金属塩を添加、混合し、5 O℃以上に加熱することで、Znハロゲン化物とMg金 属もしくは金属塩が溶解し、調製できる。

【0009】これらの有機化合物成分については、特に 制限なく広い配合比で使用でき、溶液として溶解してい さえすれば使用可能である。50℃程度でも2nハロゲ ン化物とMg金属もしくは金属塩が溶解しやすい理由は 明確ではないが、エチルメチルイミダゾリウムハロゲン 化物および有機化合物が、金属成分をイオンとして溶媒 和しているものと思われる。

【0010】 (電解条件:電流密度、浴温) 上記のよう に調製しためっき浴を用いてめっきする際の電解条件の 限定理由について述べる。電流密度を0.1~300A /dm<sup>2</sup> の範囲としたのは、0.1A/dm<sup>2</sup> 未満では 不めっきが生じ易く、300A/dm² を超えるとめっ き層がデンドライト成長をおこし、めっき焼けが生じ外 観が不良になり易くなるためである。

【0011】特に浴温については、低温から広い温度範 囲で使用できるため制限しないが、望ましくは浴温を5 0~250℃の範囲としたのは、50℃以上でZnハロ ゲン化物とMg金属もしくは金属塩が溶解し易く、でき ためっき層のめっき密着性も良好である。250℃超で 3

【0012】(めっきの付着量、被めっき材)めっきの 付着量は特に制限は設けないが、0.5~350g/m "が適当である。また本発明めっき方法は、被めっき材 として、鋼板のみならず、他に鋼管、線材、条鋼などの ・各種鋼材に適用できることは言うまでもない。鋼板とし ては、Alキルド系鋼板、Ti、Nb、等の添加極低炭 素系鋼板、髙張力鋼板などの熱延鋼板、冷延鋼板共に使 用できる。

【0013】本発明めっきを鋼板そのものにじかにめっ きしても、予め通常の水溶液から製造した電気めっき鋼 10 り曲げテストで剝離程度により評価した。 板あるいは溶融めっき鋼板であってもめっき可能であ

る。これらめっき鋼板のめっきがZnあるいはZn合金 めっきであっても、めっき可能である。

#### [0014]

【実施例】以下、実施例によって本発明をさらに詳細に 説明する。冷延鋼板を通常の脱脂、水洗、乾燥したの ち、次のめっき浴に浸漬後、表1に示す電解条件(浴 温、電流密度)で電気めっきを行った。そして電気めっ き鋼板のめっき外観、めっき密着性を調査し、その結果 を表1に併記した。なお、めっき密着性試験は、OT折

[0015]

1) 使用した浴組成 (建浴後の浴組成)

EMIB (エチレンイミダゾールブロマイド):モル比24.5

EG (エチレングリコール) : モル比65.0

ZnBr<sub>2</sub> (臭化亜鉛) :モル比 4.2

MgBr2 (臭化Mg) : モル比 6.3

尚、本裕Aは、EMIB, EG, ZnBr: を混合し、 ことにより調製した。 [0016]

非酸化性雰囲気中で所定温度に加熱、溶融したのち、金 属Mgをこの浴に浸漬し、浴中の亜鉛と化学置換させる 20

(浴B)

浴AにPEG (ポリエチレングリコール)を1g/1添加

(浴C)

EMIC (エチレンイミダゾールクロライド):モル比24.5

EG (エチレングリコール) :モル比65.0

ZnCl<sub>2</sub> (塩化亜鉛) : モル比 4.2

MgCl<sub>2</sub>(塩化Mg) : モル比 6.3

尚、本裕Cは、EMIC, EG, ZnCl<sub>2</sub> を混合し、 非酸化性雰囲気中で所定温度に加熱、溶融したのち、金 属Mgをこの浴に浸漬し、浴中の亜鉛と化学置換させる 30 ◎:剥離なし、○:剥離微小、△:剥離小、×:剥離 ことにより調製した。

【0017】2)評価方法

めっき外観の評価は目視評価により、◎:特に良好、

○:良好、△:やや不良、×:不良、とし、○以上を合 格とした。また、めっき密着性(OT曲げ)の評価は、 大、とし、〇以上を合格とした。

[0018]

【表 1 】

No.	浴組成	裕温度 (℃)	電流密度 A/dm <sup>s</sup>	めっき 密着性	めっき 外観	館 考
2	,	1 2 5	6	0	0	,
3	,,	1 2 5	1 0	0	0	
4	a	1 2 5	100	0	0	
5	8	1 2 5	300	0	0	*
6		5 0	5	0	0	,
7		8 0	5	0	0	
8		250	5	0	0	,
9	浴A	1 2 5	0.08	0		比較例
10	,	1 2 5	3 2 0	0	Δ	比較例
11	浴B	1 2 5	1 0	0	0	本発明
12	浴C	1 2 5	1 0	0	0	本発明

【0019】表1に示す通り、本発明の方法で作成した めっき鋼板 ( No. 1~8、 No. 11、No. 1 2) はめっき 密着性が良好である。それに比較して、本発明の電流密 50 【0020】

度範囲を逸脱する場合 (No. 9、No. 10) は、めっき 外観がやや不良である。

5

【発明の効果】本発明のめっき浴によれば、浴温が低温 であっても、Mg添加Znめっきが可能である。また本

発明のめっき方法は、材質劣化なく良好な外観、密着性を有するMg添加Znめっきができる。

\_ フロントページの続き

(72) 発明者 林 公隆

姬路市広畑区富士町1番地 新日本製鐵株 式会社広畑製鐵所內 F ターム(参考) 4K024 AA05 AA14 BA02 BB02 BB15 BB18 CA01 CA04 CA06 GA04